

نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی برق

موضوع: ممریستور

کد مترجم: ۲۷۰

شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید. در صورت رضایت از کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در [فرم ثبت سفارش](#) کد ارجاع به مترجم فوق را وارد نمایید.

Using memoristors in content addressable memory structures is an important step to achieve high speed and at the same time low consuming memory structures in the near future, which has been taken into consideration in recent years. Memoristor (memory resistor) is the fourth passive element of electrical circuits with a dynamic resistance that has the ability to maintain the latest levels of resistance after cutting the power supply. The content addressable memory is available in two binary and ternary types, is a widely-known and frequently-used storing structure, it's most important advantage is the high speed and the it's most vital challenge is high power consumption. In this paper we have presented new and varied architectures for content addressable memory cells (binary and ternary) based on memoristor. In the presented cells there are new patterns for the writing and searching phases, leading to significant improvements in parameters such as: the power consumption, the performance speed, the layout level and etc. ,which could lead the manufacturers to suitable options for physical construction.

استفاده از ممریستور در ساختار حافظه نشانی پذیر بر اساس محتوا گامی مهم برای دستیابی به ساختارهای حافظه پرسرعت و در عین حال کم مصرف در آینده ای نه چندان دور میباشد که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ممریستور (مموری رزیستور) چهارمین المان پسیو مدارهای الکتریکی است که دارای سطح مقاومت دینامیک با قابلیت حفظ آخرین سطح مقاومتی پس از قطع منبع تغذیه میباشد و حافظه نشانی پذیر بر اساس محتوا که در دونوع باینری و ترنری وجود دارد، یک ساختار دخیره سازی شناخته شده و پر کاربرد است که مهمترین مزیت آن سرعت بسیار بالا و مهمترین چالش آن توان مصرفی زیاد است. ما در این مقاله معماری های جدید و متنوعی برای سلولهای حافظه نشانی پذیر بر اساس محتوا (باینری و ترنری) بر مبنای ممریستور ارائه کردیم در سلولهای ارائه شده طرح های جدیدی برای فازهای نوشتن و جستجو ارائه شده است که منجر به بهبود قابل توجه در پارامترهایی از قبیل توان مصرفی، سرعت عملکرد، سطح layout و غیره گشته است که میتواند گزینه های مناسب را برای ساخت فیزیکی در اختیار سازندگان قرار دهد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی متن و مقاله